

JE9011 硅 NPN 型高频小功率晶体管

用 途：在 AM 变频器、AM/FM 的中频放大器和通用放大器中作放大和振荡用。

主要特点：

- 高频噪声系数低， $F < 4\text{dB}$ 。

- 特征频率高， $f_T > 150\text{MHz}$ 。

- 饱和压降小， $V_{CE(\text{sat})} < 0.3\text{V}$ 。

外 形：GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位：宁波无线电二厂、南京半导体器件总厂、北京电子管厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号：3DG9011

外形示意图：
(见外形示意图 5)

引出端极性：

最大额定值($T_{mb} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{ceo}	50	V
集电极-发射极电压	V_{ceo}	30	V
发射极-基极电压	V_{zeo}	5	V
集电极电流	I_C	30	mA
基极电流	I_B	10	mA
耗散功率	P_{d}	400	mW
有效结温	$T_{(e)p}$	150	°C
工作环境温度	T_{mb}	-55~+150	°C
贮存温度	T_{m}	-55~+150	°C

电特性: ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测 试 条 件	额 定 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$	28	198	—
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$	150	—	MHz
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=50\text{V}$	—	0.1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=30\text{V}$	—	0.2	μA
发射极-基极截止电流	I_{EAO}	$V_{BE}=5\text{V}$	—	0.1	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(on)}$	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=1\text{mA}$	—	0.9	v
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(on)}$	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=1\text{mA}$	—	0.3	v
共基极输出电容	C_{oB}	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_B=0$ $f=1\text{MHz}$	1.5*	—	pF
噪 声 系 数	F	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$ $f=1\text{MHz}$ $R_s=500\Omega$	—	4	dB
结到环境的热阻	$R_{th(j-toamb)}$		—	0.31	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

* 为典型值。

 h_{FE} 分 档:

h_{FE} 范 围	28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198
字 标	D	E	F	G	H	I

JE9012 硅 PNP 型高频小功率晶体管

用 途：在便携式收音机的 1W 输出放大器中作乙类推挽放大用。并与 JE9013 组成互补电路。

主要特点：· 耗散功率大， $P_{\text{tot}}=625\text{mW}$ 。

· 电流动态范围大， $I_c > 500\text{mA}$ 。

· 饱和压降低， $V_{CE(\text{sat})} < 0.6\text{V}$ 。

外 形：GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位：宁波无线电二厂、湛江无线电一厂、北京电子管厂、南京半导体器件总厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号：3CG9012

外形示意图：(见外形示意图 5)

引出端极性：

最大额定值($T_{\text{amb}}=25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{CEO}	-40	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	-20	V
发射极-基极电压	V_{BEO}	-5	V
集电极电流	I_C	500	mA
基极电流	I_B	100	mA
耗散功率	P_{tot}	625	mW
有效结温	T_{vj}	150	℃
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	℃
贮存温度	T_{st}	-55~+150	℃

电特性: ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测 试 条 件	额 定 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	h_{FE1}	$V_{CE} = -1\text{V}$ $I_C = 50\text{mA}$	64	202	—
共发射极直流电流放大系数	h_{FE2}	$V_{CE} = -1\text{V}$ $I_C = 500\text{mA}$	40	—	—
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = -25\text{V}$	—	0.1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = -10\text{V}$	—	1	μA
发射极-基极截止电流	I_{BEO}	$V_{BE} = -3\text{V}$	—	0.1	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(on)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$	—	1.2	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(on)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$	—	0.6	V
结到环境的热阻	$R_{th(j-to-sink)}$		—	0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

 h_{FE} 分 档:

h_{FE} 范 围	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202
字 标	D	E	F	G	H

JE9013 硅 NPN 型高频小功率晶体管

用 途:在便携式收音机的 1W 输出放大器中作乙类推挽放大用。并与 JE9012 组成互补电路。

主要特点: • 耗散功率大, $P_{\text{diss}} = 625 \text{ mW}$ 。
• 电流动态范围大, $I_c > 500 \text{ mA}$ 。
• 饱和压降低, $V_{CE(\text{sat})} < 0.6 \text{ V}$ 。

外 形: GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位: 宁波无线电二厂、湛江无线电一厂、北京电子管厂、南京半导体器件总厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号: 3DG9013

外形示意图: (见外形示意图 5)

引出端极性:

最大额定值($T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{CEO}	40	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	20	V
发射极-基极电压	V_{BEE}	5	V
集电极电流	I_C	500	mA
基极电流	I_B	100	mA
耗散功率	P_{diss}	625	mW
有效结温	T_{vj}	150	°C
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	°C
贮存温度	T_{st}	-55~+150	°C

电特性: ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测试条件	额定值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	β_{FE}	$V_{CE} = 1\text{V}$ $I_C = 50\text{mA}$	64	202	—
共发射极直流电流放大系数	β_{FE2}	$V_{CE} = 1\text{V}$ $I_C = 500\text{mA}$	40	—	—
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 25\text{V}$	—	0.1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 10\text{V}$	—	1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = 3\text{V}$	—	0.1	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$	—	1.2	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 500\text{mA}$ $I_B = 50\text{mA}$	—	0.6	V
结到环境的热阻	$R_{th(j-to-a)}$		—	0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

 β_{FE} 分 档:

β_{FE} 范围	64~91	78~112	96~135	112~166	144~202
字 标	D	F	F	G	H

JE9014 硅 NPN 型高频小功率晶体管

用 途:在低电平和低噪声的前置放大器中作放大和振荡用。并与 JE9015 组成互补电路。

主要特点: • 耗散功率大, $P_{\text{diss}} = 625\text{mW}$ 。

• 特征频率高, $f_T > 150\text{MHz}$ 。

• 饱和压降低, $V_{CE(\text{sat})} < 0.3\text{V}$ 。

外 形:GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位:宁波无线电二厂、南京半导体器件总厂、北京电子管厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号:3DG9014

外形示意图: (见外形示意图 5)

引出端极性:

最大额定值($T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{CBO}	50	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	45	V
发射极-基极电压	V_{EBO}	5	V
集电极电流	I_C	100	mA
基极电流	I_B	100	mA
耗散功率	P_{diss}	450	mW
有效结温	$T_{(v)}$	150	℃
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	℃
贮存温度	T_{st}	-55~+150	℃

电特性: ($T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测试条件	额定值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$	60	1000	—
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=10\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$	150	—	MHz
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CB}=50\text{V}$	—	0.05	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=40\text{V}$	—	1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}$	—	0.05	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=5\text{mA}$	—	1	v
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$ $I_B=5\text{mA}$	—	0.3	v
共基极输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$	—	3.5	pF
噪声系数	F	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=0.2\text{mA}$ $f=1\text{kHz}$ $\Delta f=200\text{Hz}$	—	10	dB
结到环境的热阻	$R_{th(j-amb)}$		---	0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

 h_{FE} 分 档:

h_{FE} 范 围	60~150	100~300	200~600	400~1000
字 标	A	B	C	D

JE9015 硅 PNP 型高频小功率晶体管

用 途：在低电平和低噪声的前置放大器中作放大和振荡用。并与 JE9014 组成互补电路。

主要特点：· 耗散功率大， $P_{\text{d}} = 625\text{mW}$ 。

· 特征频率高， $f_T > 100\text{MHz}$ 。

· 电流放大系数线性好。

外 形：GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位：宁波无线电二厂、南京半导体器件总厂、北京电子管厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号：3CG9015

外形示意图：(见外形示意图 5)

引出端极性：

最大额定值($T_{\text{amb}} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{ceo}	-60	V
集电极-发射极电压	V_{ceo}	-45	V
发射极-基极电压	V_{beo}	-5	V
集电极电流	I_C	100	mA
基极电流	I_B	100	mA
耗散功率	P_{d}	450	mW
有效结温	$T_{(\text{vj})}$	150	°C
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	°C
贮存温度	T_{st}	-55~+150	°C

电特性: ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测 试 条 件	额 定 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	β_{FE}	$V_{CE} = -5\text{V}$ $I_C = 1\text{mA}$	60	600	—
特征频率	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}$ $I_C = 10\text{mA}$ $f = 30\text{MHz}$	100	—	MHz
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CE} = -50\text{V}$	—	0.05	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = -40\text{V}$	—	1	μA
发射极-基极截止电流	I_{BEO}	$V_{BE} = -5\text{V}$	—	0.05	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 100\text{mA}$ $I_B = 10\text{mA}$	—	1	v
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100\text{mA}$ $I_B = 10\text{mA}$	—	0.7	v
共基极输出电容	C_{ob}	$V_{CE} = -10\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	—	7	pF
噪 声 系 数	F	$V_{CE} = -5\text{V}$ $I_C = 0.2\text{mA}$ $f = 1\text{kHz}$ $\Delta f = 200\text{Hz}$	—	10	dB
结到环境的热阻	$R_{th(j-to-s)}$		—	0.2	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

 β_{FE} 分 挡:

β_{FE} 范 围	60~150	100~300	200~600
字 标	A	B	C

JE9016 硅 NPN 型高频小功率晶体管

用 途：在 AM 变频器和 FM 低噪声射频放大器中作放大和振荡用。

主要特点：

- 特征频率高, $f_T > 400\text{MHz}$ 。

- 高频噪声系数低, $F < 5\text{dB}$ 。

- 饱和压降小, $V_{CE(\text{sat})} < 0.3\text{V}$ 。

外 形：GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位：宁波无线电二厂、南京半导体器件总厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号：3DG9016

外形示意图：(见外形示意图 5)

引出端极性：

最大额定值($T_{amb}=25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{CEO}	30	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	20	V
发射极-基极电压	V_{EBO}	4	V
集电极电流	I_C	25	mA
基极电流	I_B	5	mA
耗散功率	P_{DQ}	400	mW
有效结温	T_{vj}	150	°C
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	°C
贮存温度	T_{st}	-55~+150	°C

电特性: ($T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	测 试 条 件	额 定 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 1\text{mA}$	28	198	—
特征频率	f_T	$V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 1\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	400	—	MHz
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 30\text{V}$	—	0.1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 20\text{V}$	—	1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EAO}	$V_{BE} = 3\text{V}$	—	0.1	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(on)}$	$I_C = 10\text{mA}$ $I_B = 1\text{mA}$	—	0.9	v
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(on)}$	$I_C = 10\text{mA}$ $I_B = 1\text{mA}$	—	0.3	v
共基极输出电容	C_{ob}	$V_{CE} = 10\text{V}$ $I_B = 0$ $f = 1\text{MHz}$	—	1.6	pF
噪 声 系 数	F	$V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 1\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$	—	5	dB
结到环境的热阻	$R_{th(j-amb)}$		—	0.31	$^\circ\text{C}/\text{mW}$

 h_{FE} 分 档:

h_{FE} 范 围	28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198
字 标	D	E	F	G	H	I

JE9018 硅 NPN 型高频小功率晶体管

用 途: 在 AM/FM 的中频放大器和 FM/UHF 调谐器的本机振荡器中作放大和振荡用。

主要特点: • 特征频率高, $f_T = 1100\text{MHz}$ (典型值)。

• 对电源电压变化和环境温度变化具有稳定的振荡和小的频率漂移。

外 形: GB7581 中的 A3-07A 型(TO-92)。

国内主要生产单位: 宁波无线电二厂、桂林无线电一厂、广州半导体器件厂

国内型号: 3DG9018

外形示意图: (见外形示意图 5)

引出端极性:

最大额定值($T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)

名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-基极电压	V_{CEO}	30	V
集电极-发射极电压	V_{CEO}	15	V
发射极-基极电压	V_{EBO}	5	V
集电极电流	I_C	50	mA
基极电流	I_B	10	mA
耗散功率	P_{sd}	400	mW
有效结温	$T_{(v)}$	150	°C
工作环境温度	T_{amb}	-55~+150	°C
贮存温度	T_{st}	-55~+150	°C

电特性: ($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)

名 称	符 号	测 试 条 件	额 定 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
共发射极直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=1\text{mA}$	28	198	—
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}$ $I_C=5\text{mA}$ $f=400\text{MHz}$	700	—	MHz
集电极-基极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=12\text{V}$	—	0.05	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=10\text{V}$	—	0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EAO}	$V_{CE}=3\text{V}$	—	0.05	μA
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(on)}$	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=1\text{mA}$	—	0.95	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(on)}$	$I_C=10\text{mA}$ $I_B=1\text{mA}$	—	0.5	V
共基极输出电容	C_{ab}	$V_{CE}=10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1\text{MHz}$	—	1.7	pF
结到环境的热阻	$R_{th(\text{Case})}$		—	0.31	C/mW

 h_{FE} 分 档:

h_{FE} 范 围	28~45	39~60	54~80	72~108	97~146	132~198
字 标	D	E	F	G	H	I